







	<h2>SI7792DP-T1-GE3</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: SI7792DP-T1-GE3</p> <p>Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 30V P-PACK SO-8</p> <p>Datenblätter:  SI7792DP-T1-GE3.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 1000 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SI7792DP-T1-GE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET N-CH 30V P-PACK SO-8
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	1000 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	N-Channel 30V 40.6A (Ta), 60A (Tc) 6.25W (Ta),
Serie	SkyFET®, TrenchFET® Gen III
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	PowerPAK® SO-8
Supplier Device-Gehäuse	PowerPAK® SO-8
Verlustleistung (max)	6.25W (Ta), 104W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	Schottky Diode (Body)
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	40.6A (Ta), 60A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	2.1 mOhm @ 20A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	2.5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	135nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	4.735nF @ 15V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)

SI7792DP-T1-GE3 ist neu im Original, Suche SI7792DP-T1-GE3 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie SI7792DP-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen. Anfrage SI7792DP-T1-GE3: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>SI7794DP-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 30V P-PACK SO-8</p>	 <p>SI7788DP-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 30V 50A PPAK SO-8</p>	 <p>SI7790DP-T1-E3 VISHAY SI7790DP-T1-E3 VISHAY</p>	 <p>SI7794DP-T1-GE3 VISHAY VISHAY PAKSO8</p>
 <p>SI7792DP-T1-E3 VISHAY VISHAY PAKSO-8</p>	 <p>SI7798DP-T1-GE3 Vishay Precision Group SI7798DP-T1-GE3 VISHAY</p>	 <p>SI7790DP-T1-GE3 Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 40V 50A PPAK SO-8</p>	 <p>SI7794DP-T1-E3 VISHAY VISHAY PAKSO-8</p>

heiße Teile

Mehr

SI7738DP	SI7738DP-T1-3	SI7738DP-T1-E3	D SI7738DP-T1-E3	SI7738DP-T1-GE3
SI7738DP-T1-GE3	SI7742DP-T1-E3	D SI7742DP-T1-GE3	SI7742DP-T1-GE3	SI7748DP-T1-GE3
SI7748DP-T1-GE3	SI7758DP	SI7758DP-T1-GE3	SI7758DP-T1-GE3	SI7772DP-T1-GE3
D SI7772DP-T1-GE3	SI7774DP-T1-GE3	SI7774DP-T1-GE3	SI7784DP-T1-GE3	SI7784DP-T1-GE3
SI7788DP-T1-GE3	SI7788DP-T1-GE3	SI7790DP-T1-E3	SI7790DP-T1-GE3	SI7790DP-T1-GE3
SI7792DP-T1-GE3	SI7794DP-T1-GE3	D SI7794DP-T1-GE3	SI7798DP-T1-GE3	SI7804DN
SI7804DN-T1-E3	D SI7804DN-T1-E3	SI7806ADN	SI7806ADN-T1-E3	SI7806ADN-T1-E3
SI7806ADN-T1-E3-PBF	SI7806ADN-T1-GE3	SI7806ADN-T1-GE3	SI7806AEDN-T1-E3	SI7806BDN
SI7806BDN-T1-GE3	SI7806DN-T1-E3	SI7806DN-T1-GE3	D SI7810DN	SI7810DN-T1
SI7810DN-T1-E	SI7810DN-T1-E3	SI7810DN-T1-E3	SI7812DN-T1-E3	SI7812DN-T1-E3

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited